

SJ

中华人民共和国电子行业军用标准

FL 5980

SJ 20642/2 — 1998

半导体光电模块 GD82 型 PIN - FET 光接收模块详细规范

Semiconductor opto - electronic module
Detail specification for type
GD82 PIN - FET opto - receiver module

1998 - 03 - 11 发布

1998 - 05 - 01 实施

中华人民共和国电子工业部 批准

半导体光电模块 GD82 型
PIN - FET 光接收模块详细规范

SJ 20642/2—1998

Semiconductor opto - electronic module Detail specification
for type GD82 PIN - FET opto - receiver module

1 范围

1.1 主题内容

本规范规定了 GD82 型 PIN - FET 光接收模块的详细要求。

1.2 适用范围

本规范适用于 GD82 型 PIN - FET 光接收模块（以下简称模块）的研制，生产和采购。按 SJ 20642 《半导体光电模块总规范》 1.1 条的规定，提供的质量保证等级为 M1 和 M2 二级。

1.3 绝对最大额定值

绝对最大额定值如下：

项 目	符 号	数 值		单 位
		最 小	最 大	
贮存温度	T_{stg}	-40	85	℃
耗散功率	P_{tot}	-	0.2	W
正电源电压	V_{DD1}	-	5.5	V
负电源电压	V_{DD2}	-	-5.7	V

1.4 推荐工作条件

推荐工作条件如下：

项 目	符 号	规 范 值		单 位
		最 小	最 大	
工作环境温度	T_A	-25	70	℃
正电源电压	V_{DD1}	4.75	5.25	V
负电源电压	V_{DD2}	-4.95	-5.45	V
工作波长	λ	1.29	1.33	μm

2 引用文件

- GJB 128 — 86 半导体分立器件试验方法
- GJB 150 — 86 军用设备环境试验方法
- GJB 179 — 86 计数抽样程序及表
- GJB 548 — 88 微电子器件试验方法和程序
- GJB 915 — 90 纤维光学试验方法
- SJ 20642 — 97 半导体光电模块规范

3 要求

3.1 详细要求

各项要求应按 SJ 20642 和本规范的规定。

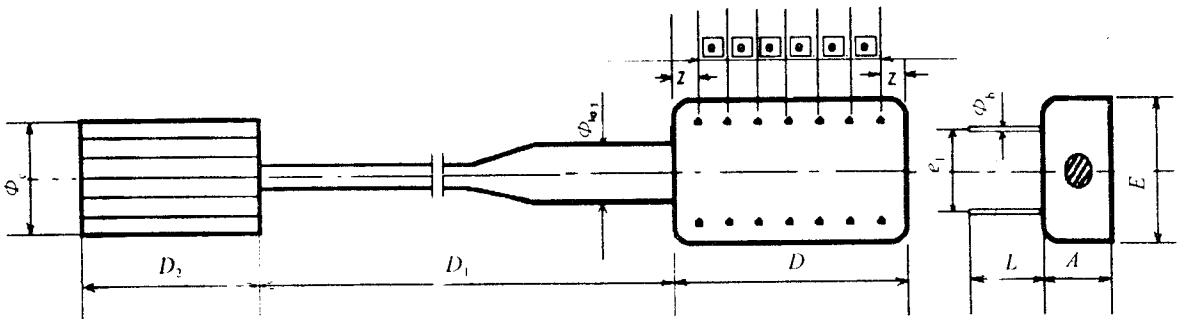
3.2 设计、外形结构和尺寸

3.2.1 设计

本模块的设计应满足本规范对性能指标和技术图纸的规定。

3.2.2 外形结构和尺寸

模块的外形结构和尺寸应符合图 1 的规定。



尺寸	符号	D	D_1	D_2	E	A	L	e	e_1	z	Φ_b	Φ_c	Φ_d
	数值 (mm)	最小公称		500				4					
	最大	20.8		16	12.8	5.7		2.54	7.6	3.0	0.55	10.5	5.0

图 1 外形尺寸

3.2.3 质量 (重量)